

Silicon Varicap Dual Diode

BB804

FM Tuning Diode

1..28V / 1,65-47,5pF

DATASHEET

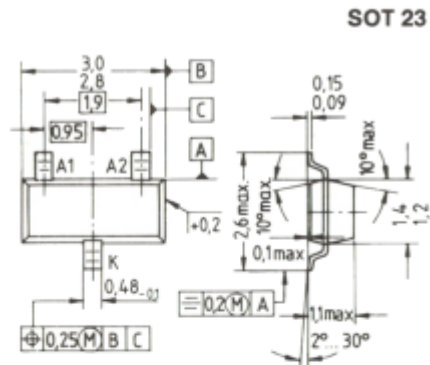
OEM – Siemens

Source: Siemens Databook 1986/87

Silizium-Zweifach-Abstimm-diode

BB 804

- Für FM-Tuner
- Monolithische Konstruktion mit gemeinsamer Kathode gewährleistet Gleichlauf beider Teildioden
- Gleichmäßiger Kapazitätsverlauf nach quadratischem Gesetz
- Geeignet für verzerrungsfreie Gegentaktschaltung in HiFi-Tunern Kapazitätsgruppen verfügbar
- Kunststoff-Miniaturgehäuse für Oberflächenmontage (SMD)



Typ	BB 804	
Best.-Nr.	Schüttgut: Q62702-B328	Gurt: Q62702-B356
Stempel	SF (Kapazitätsgruppenkennung siehe nächste Seite)	

Grenzdaten je Diode

Sperrspannung	V_R	18	V
Spitzensperrspannung	V_{RM}	20	V
Durchlaßstrom	I_F	50	mA
$T_A \leq 60^\circ\text{C}$			
Betriebstemperatur	T_{op}	100	$^\circ\text{C}$
Lagertemperatur	T_{stg}	- 65... + 150	$^\circ\text{C}$

BB 804

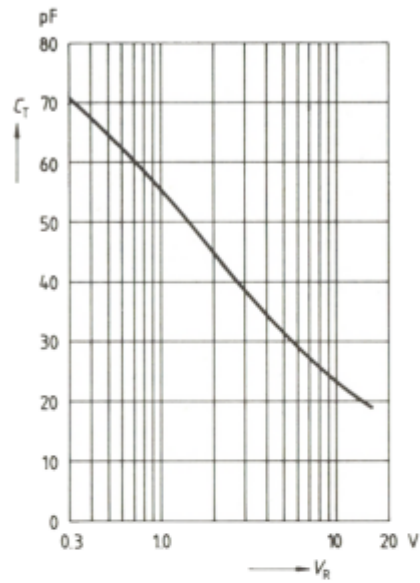
Kenndaten je Diode ($T_A = 25\text{ °C}$)

		min	typ	max	
Sperrstrom	I_R	—	—	20	nA
$V_R = 16\text{ V}$		—	—	200	nA
$16\text{ V}, T_A = 60\text{ °C}$					
Diodenkapazität	C_T	42	—	47,5	pF
$V_R = 2\text{ V}, f = 1\text{ MHz}$					
Kapazitätsverhältnis	$\frac{C_{T2}}{C_{T8}}$	1,65	1,7	—	—
$V_R = 2\text{ V}, 8\text{ V}; f = 1\text{ MHz}$					
Serienwiderstand	r_s	—	0,25	—	Ω
$C_T = 38\text{ pF}, f = 100\text{ MHz}$					
Gütefaktor	Q	—	170	—	—
$C_T = 38\text{ pF}, f = 100\text{ MHz}$					
Temperaturkoeffizient der Diodenkapazität	TC_C	—	330	—	ppm/K
$V_R = 2\text{ V}, f = 1\text{ MHz}$					
Kapazitätsgruppen ¹⁾	C_T				
$V_R = 2\text{ V}, f = 1\text{ MHz}$					
Gruppe 0		42	—	43,5	pF
1		43	—	44,5	pF
2		44	—	45,5	pF
3		45	—	46,5	pF
4		46	—	47,5	pF

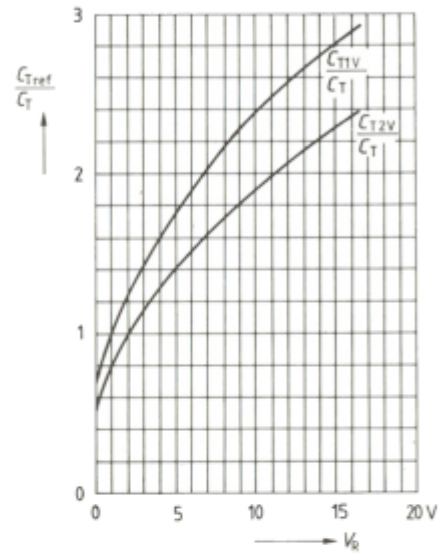
¹⁾ Die Kapazitätsgruppe ist auf dem Bauelement durch Bestempelung mit der Gruppen-Nr. gekennzeichnet und auf dem Packzettel vermerkt. Eine Verpackungseinheit (z. B. 8-mm-Gurt) enthält nur Dioden einer Sortiergruppe. Eine Bestellung **einzelner** Kapazitätsgruppen ist nur auf Anfrage möglich.

BB 804

Diodenkapazität $C_T = f(V_R)$
je Diode, $f = 1$ MHz



Kapazitätshub $\frac{C_{Tref}}{C_T} = f(V_R)$
je Diode; $V_{ref} = 1$ V, 2 V; $f = 1$ MHz



Temperaturkoeffizient $TC_C = f(V_R)$
je Diode, $f = 1$ MHz

